

产品概览

NCP5183: 高电压 4.3 A 高压侧和低压侧驱动器

欲看完整文档，请参阅数据表。

NCP5183 是一款高电压高电流 功率 MOSFET 驱动器，提供两个输出，用于驱动 2 个组织为半桥（或任何其他高压侧 + 低压侧）配置的 N 沟道功率 MOSFET。它使用自举技术来确保高压侧电源开关的恰当驱动。该驱动器使用 2 个独立输入可适应任何拓扑结构（包括半桥、不对称半桥、有源箝位和全桥）。

特性

- Output Source / Sink Current Capability 4.3 A / 4.3 A
- Extended Allowable Negative Bridge Pin Voltage Swing to – 10 V
- Voltage Range up to 600 V with dV/dt Immunity ± 50 V/ns
- Gate Drive Supply Range from 9 V to 18 V
- Automotive Qualified to AEC Q100

优势

- Can drive big MOSFET, IGBT's
- Rugged design

应用

- High Voltage Synchronous-Buck Converters
- Half-Bridge and Full-Bridge Converters
- Electric Power Steering & Motor Control

终端产品

- Power Supplies for Telecom and Datacom
- Push-Pull Converters
- Automotive power conversion

器件电气规格

产品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Power Switch	Number of Outputs	Topology	Isolation Type	V _{in} Max (V)	V _{CC} Max (V)	Drive Source / Sink Typ (mA)	Rise Time (ns)	Fall Time (ns)	t _o Max (ns)	Package Type
NCP5183DR2G	0.9333	Pb-free Halide free	Active	MOSFET / IGBT	2	High-Low	Junction Isolation	600	18	4300 / 4300	12	12	200	SOIC-8
NCV5183DR2G	1.9653	AEC Qualified PPAP Capable Pb-free Halide free	Active	MOSFET / IGBT	2	High-Low	Junction Isolation	600	18	4300 / 4300	12	12	200	SOIC-8

欲了解更多信息，请联系您当地的销售支援 www.onsemi.cn。

创建于：3/28/2020